

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 10 月 6 日 (06.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/093805 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 21/304
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005769
(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 28 日 (28.03.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2004-096850 2004 年 3 月 29 日 (29.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ニッタ・ハース株式会社 (NITTA HAAS INCORPORATED) [JP/JP]; 〒5560022 大阪府大阪市浪速区桜川 4-4-26 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田 慶治 (OHTA, Yoshiharu) [JP/JP]; 〒6391032 奈良県大和郡山市池沢町 172 ニッタ・ハース株式会社 奈良工場内 Nara (JP). 板井 康行 (ITAI, Yasuyuki) [JP/JP]; 〒6391032 奈良県大和郡山市池沢町 172 ニッタ・ハース株式会社 奈良工場内 Nara (JP).

(74) 代理人: 西教 圭一郎, 外 (SAIKYO, Keiichiro et al.); 〒5410051 大阪府大阪市中央区備後町 3 丁目 2 番 6 号 敷島ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITION FOR POLISHING SEMICONDUCTOR

(54) 発明の名称: 半導体研磨用組成物

(57) Abstract: A composition for polishing a semiconductor capable of polishing a semiconductor device efficiently and highly precisely without causing a polishing flaw in the semiconductor device while preventing aggregation of fumed silica. Fumed silica where the bulk density of powder before dispersion is not less than 50 g/L and less than 100 g/L is employed as abrasive grains. More preferably, the bulk density is not less than 75 g/L and not more than 85 g/L. Consequently, dispersion state of fumed silica is improved and transportation cost can be reduced.

(57) 要約: 本発明の目的は、ヒュームドシリカの凝集を防止し、半導体デバイスに研磨傷を発生させることなく、半導体デバイスを効率良くかつ高精度に研磨することができる半導体研磨用組成物を提供することである。分散前における粉体のかさ密度が 50 g/L 以上 100 g/L 未満のヒュームドシリカを砥粒として用いる。かさ密度が 75 g/L 以上 85 g/L であればより好ましい。これにより、ヒュームドシリカの分散状態を良好にし、かつ、輸送コストの低減も実現できる。

WO 2005/093805 A1